

2SC1848

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

中出力電力増幅用 / Medium Power Amplifier

2SA887 とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SA887

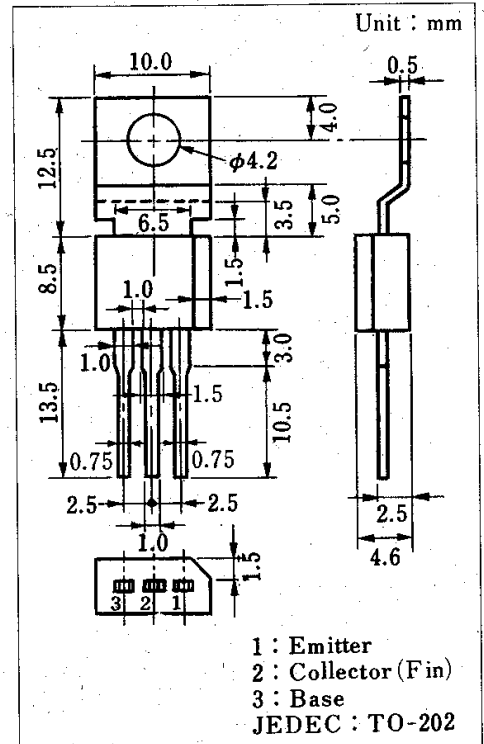
■ 特徴 / Feature

- 2SA887 とコンプリメンタリペアで出力 7 W が得られます。

7 W output in complementary pair with 2SA887

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit	
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	70	V	
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	50	V	
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	5	V	
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	3	A	
コレクタ電流	I _C	2	A	
コレクタ損失	P _C	Ta=25 °C	1.2	W
		Tc=25 °C	10	W
接合部温度	T _j	150	°C	
保存温度	T _{stg}	-55~+150	°C	



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Tc=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =40 V, I _E =0			1	μA
	I _{CEO}	V _{CE} =20 V, I _B =0			100	
エミッタしゃ断電流	I _{EB0}	V _{EB} =5 V, I _C =0			10	μA
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	I _C =1 mA, I _E =0	70			V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C =10 mA, I _B =0	50			V
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} =5 V, I _C =100 mA	30			
	h _{FE2} *1	V _{CE} =5 V, I _C =1 A*2	50	130	220	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =1 A, I _B =0.1 A		0.6	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =2 A, I _B =0.2 A		1	1.5	V
トランジション周波数	f _T	V _{CB} =5 V, I _E =-0.5 A*2		150		MHz

*2 パルス測定 / Pulse Test

*1 h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	P	Q	R
h _{FE2}	50~100	80~160	120~220